

國立中興大學專利讓與公告清單

公告日期 111 年 8 月 01 日-111 年 11 月 01 日

序號	校內編號	專利名稱(中文)	專利國別	專利類型	獲證公告日	專利證書號	專利起始日	專利截止日	成果來源
1	095PF130	可規畫平行循環冗餘檢查電路及攪散器電路	中華民國	發明	20100721	I327704	20100721	20261226	經濟部
2	099PE1003L	低表面缺陷密度之磊晶基板	美國	發明	20110920	US 8,022,412 B2	20100120	20300119	經濟部
3	099PE1005L	低表面缺陷密度的外延基板及其製造方法	中國大陸	發明	20120321	921871	20090420	20290420	經濟部
4	099PE1002L	低表面缺陷密度之磊晶基板及其製造方法	韓國	發明	20120524	10-1148380	20120511	20300120	經濟部
5	099PE1006S	光電元件之磊晶基板的分離方法	美國	發明	20121002	US 8,278,194 B2	20110314	20310313	經濟部
6	098PF213	磊晶用基板的製造方法	中華民國	發明	20121021	I375258	20121021	20281229	經濟部
7	098PF209	低表面缺陷密度之磊晶基板	中華民國	發明	20121201	I378556	20121201	20290120	經濟部
8	098PF212	發光元件模組的製作方法	中華民國	發明	20121211	I379444	20121211	20281229	經濟部
9	099PE1001L	低表面缺陷密度之磊晶基板之製造方法	日本	發明	20130111	5174052	20100120	20300120	經濟部
10	098PF210	磊晶用基板	中華民國	發明	20130201	I384535	20130201	20281229	經濟部
11	099PE0008	磊晶基板的製造方法	中華民國	發明	20130521	I397114	20130521	20300712	經濟部
12	099PE0003	光電元件之磊晶基板的分離方法	中華民國	發明	20130601	I398022	20130601	20300316	經濟部
13	099PE0001	盛鋼桶鋼水精鍊脫硫劑及脫硫方法	中華民國	發明	20130611	I398525	20130611	20300114	經濟部
14	098PF211	光電元件的製造方法	中華民國	發明	20130811	I405353	20130811	20281229	經濟部
15	099PF0037	盛鋼桶鋼水精鍊脫硫劑組成物及脫硫方法	中華民國	發明	20130911	I408237	20130911	20301228	中興大學 經濟部
16	099PE0006	具蝕刻通道的磊晶結構及其製造方法	中華民國	發明	20131121	I416617	20131121	20300617	經濟部
17	099PE0009	填充砂粒	中華民國	發明	20131201	I417268	20131201	20310417	經濟部
18	098PF258	氮雜環-2,4-雙酮系化合物、利用其製得的化合物及聚(醯胺-胺酯)	中華民國	發明	20131211	I418541	20131211	20300126	經濟部
19	100PE0003	具有大發光面積的發光二極體封裝結構	中華民國	發明	20140321	I431824	20140321	20310925	經濟部
20	100PE0004	具有微透鏡的發光二極體晶粒元件的製作方法及其成品	中華民國	發明	20140321	I431823	20140321	20310925	經濟部
21	099PE0007	磊晶基板的製造方法<雷射破壞>	中華民國	發明	20140611	I441241	20140611	20300712	經濟部
22	101PE0005	垂直導通式發光二極體的製作方法及其製品	中華民國	發明	20141111	I460891	20141111	20320816	經濟部
23	101PE0003	具有高散熱特性的發光元件的製作方法及該方法製得的發光元件	中華民國	發明	20141221	I466347	20141221	20320712	經濟部

序號	校內編號	專利名稱(中文)	專利國別	專利類型	獲證公告日	專利證書號	專利起始日	專利截止日	成果來源
24	099PE1007S	磊晶用基板	美國	發明	20140722	US 8,785,947 B2	20091228	20320506	經濟部
25	101PE0004	磊晶基板的製作方法	中華民國	發明	20150221	I474381	20150221	20320816	經濟部
26	098PF208	低表面缺陷密度之磊晶基板的製造方法	中華民國	發明	20150421	I482214	20150421	20290120	經濟部
27	102PE0003	半導體光電元件及其製造方法	中華民國	發明	20160221	I523244	20160221	20340330	經濟部
28	101PC0022	半導體發光晶片	中華民國	發明	20160311	I525865	20160311	20320614	科技部 經濟部
29	103PE0001	酒精純化之循環製程	中華民國	發明	20160601	I535687	20160601	20340515	經濟部
30	103PE0003	工具機的設定方法	中華民國	發明	20160611	I537091	20160611	20341110	經濟部
31	100PE0005	煉鋼用調整劑	中華民國	發明	20150611	I487794	20150611	20320111	經濟部
32	101PE0002	固態發光結構的製造方法	中華民國	發明	20150721	I493755	20150721	20320517	經濟部
33	103PE1001	高光萃取率的發光二極體、導電膜，及導電膜的製作方法	美國	發明	20160503	US 9,331,250B1	20150121	20350120	經濟部
34	104PE0001	微奈米化鈉質膨潤土、其製備方法及其用途	中華民國	發明	20170711	I591159	20170711	20360714	經濟部
35	100PF0041	熔融鋼液之脫硫方法	中華民國	發明	20151111	I507531	20151111	20320105	中興大學 經濟部
36	098PF254	堆疊式太陽能電池的製造方法及其製品	中華民國	發明	20121011	I374550	20121011	20290816	原能會
37	099PC1019	具蝕刻停止層的磊晶結構及其製造方法	韓國	發明	20131210	10-1341824	20111222	20311222	科技部 經濟部
38	099PC1018	具蝕刻停止層的磊晶結構及其製造方法	美國	發明	20131210	US 8,603,886 B2	20111220	20320208	科技部 經濟部
39	099PC1017	具蝕刻停止層的磊晶結構及其製造方法	中國大陸	發明	20141217	ZL 201110428930.3 (證書號第 1546394 號)	20111220	20311220	科技部 經濟部
40	099PC1020	具易移除犧牲層的磊晶結構及其製造方法	中國大陸	發明	20150617	ZL 201110428953.4 (證書號第 1696498 號)	20111220	20311220	科技部 經濟部
41	099PC1021	具易移除犧牲層的磊晶結構及其製造方法	美國	發明	20140325	US 8,680,554 B2	20111220	20320201	科技部 經濟部
42	099PC0067	磊晶用基板及其製作方法	中華民國	發明	20141221	I466287	20141221	20301121	科技部 經濟部
43	098PC054	超薄型線光源模組	中華民國	發明	20120801	I369463	20120801	20290722	科技部 經濟部
44	099PC0060	具蝕刻停止層的磊晶結構及其製造方法	中華民國	發明	20140411	I434329	20140411	20301222	科技部 經濟部
45	097PC088	雙面粗化垂直導通式發	中華	發明	20150401	I479689	20150401	20290415	科技部

序號	校內編號	專利名稱(中文)	專利國別	專利類型	獲證公告日	專利證書號	專利起始日	專利截止日	成果來源
		光二極體及其製作方法	民國						經濟部
46	101PC0013	半導體元件的製造方法及該製造方法中所使用的磊晶基板與其半導體元件半成品	中華民國	發明	20150411	I480928	20150411	20320521	科技部 經濟部
47	099PE1007S	磊晶用基板	美國	發明	20140722	US 8,785,947 B2	20091228	20320506	經濟部
48	100PE0002	垂直導通結構發光二極體的製作方法及其製品	中華民國	發明	20170911	I599069	20170911	20310714	經濟部
49	099PF0034X	兼具生物可降解性及生物可相容性之水性聚胺酯	中華民國	發明	20140221	I427091	20140221	20301027	經濟部
50	099PC1024	磊晶用基板及其製作方法	美國	發明	20160712	US 9391235 B2	20111118	20341003	科技部 經濟部